MBR16100 THRU MBR16200

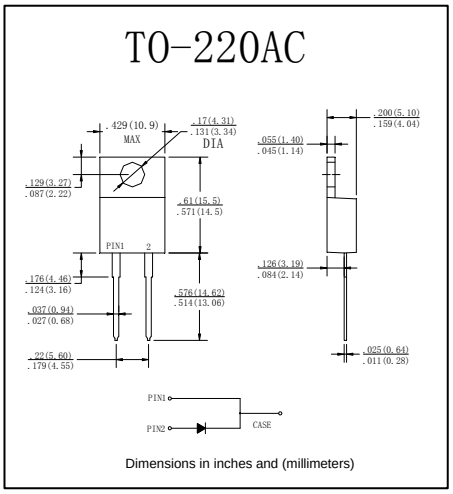
RoHS COMPLIANT

肖特基二极管SCHOTTKY Diodes

■特征 Features

- 耐正向浪涌电流能力高
  High surge forward current capability
- 低功耗，大电流
  Low Power loss, High efficiency
- I_o 16.0A
- V_{RRM} 100-200V

■外形尺寸和印记 Outline Dimensions and Mark



■用途 Applications

- 快速整流用
  High speed switching

■极限值（绝对最大额定值）
Limiting Values（Absolute Maximum Rating）

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	MBR		
				16100	16150	16200
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	V		100	150	200
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	I_o	A	正弦半波60Hz，电阻负载，Tc(Fig.1) 60HZ Half-sine wave, Resistance load, Tc(Fig.1)	16		
正向（不重复）浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	I_{FSM}	A	60Hz正弦波，一个周期，T_a=25℃ 60Hz sine wave, 1 cycle, T_a=25℃	250		
正向浪涌电流的平方对电流浪涌持续时间的积分值 Current Squared Time	I^2t	A^2s	1ms≤t＜8.3ms T_j=25℃,单个二极管 1ms≤t＜8.3ms T_j=25℃,Rating of per diode	261		
贮存温度 Storage Temperature	T_{stg}	℃		-55 ~ +150		
结温 Junction Temperature	T_j	℃	在正向直流条件下，没有施加反向压降，通电≤1h（图示1）① IN DC Forward Mode-Forward Operations，without reverse bias, t ≤1 h (Fig. 1)①	-55 ~ +150		

■电特性 （T_a=25℃ 除非另有规定）
Electrical Characteristics（T_a=25℃ Unless otherwise specified）

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition		最大值 Max MBR		
					16100	16150	16200
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	V_{FM}	V	I FM =16.0A		0.85	0.9	0.95.
反向峰值电流 Peak Reverse Current	I_{RRM1}	mA	V_{RM} =V_{RRM}	T_a=25℃	0.05		
	I_{RRM2}			T_a=100℃	1		
热阻 Thermal Resistance	$R_{\theta J-C}$	℃/W	结和壳之间 Between junction and case		2.0		

■ 备注 NOTE

①**Meets the requirements of IEC 61215 Ed. 2 bypass diode thermal test.**

■ 特性曲线（典型） **Characteristics(Typical)**

图1：正向电流降额曲线

FIG1: IF（AV）--Tc Derating

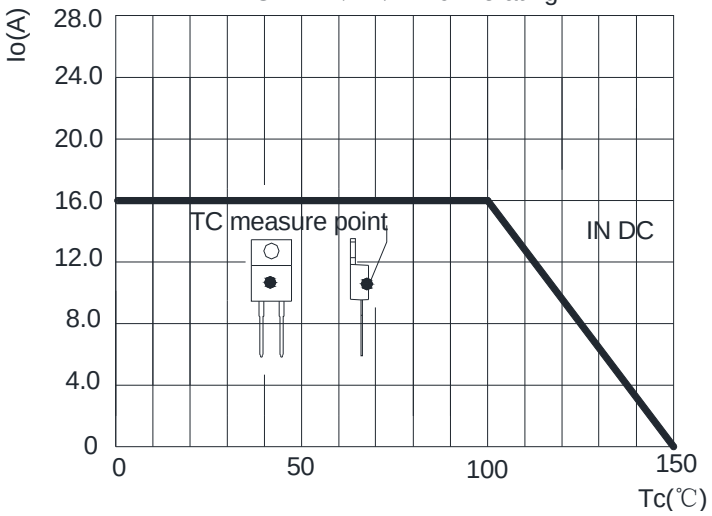


图2：耐正向浪涌电流曲线

FIG2:Surge Forward Current Capadility

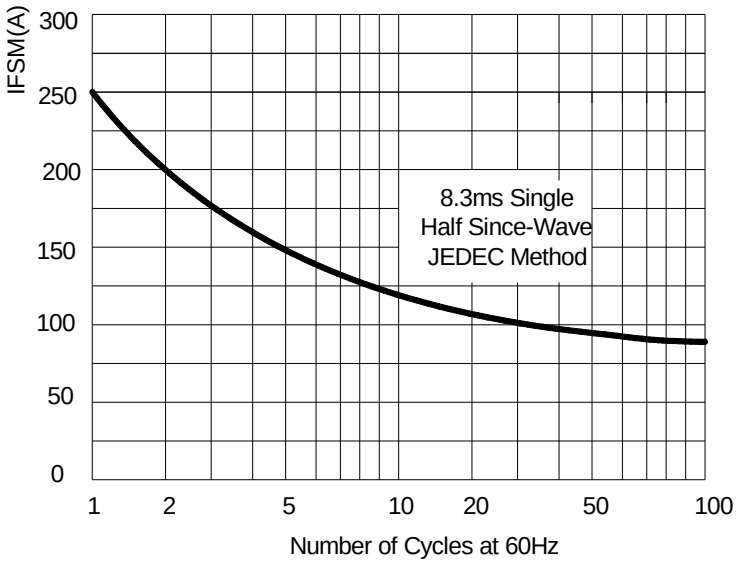


图3：正向电压曲线

FIG3:Instantaneous Forward Voltage

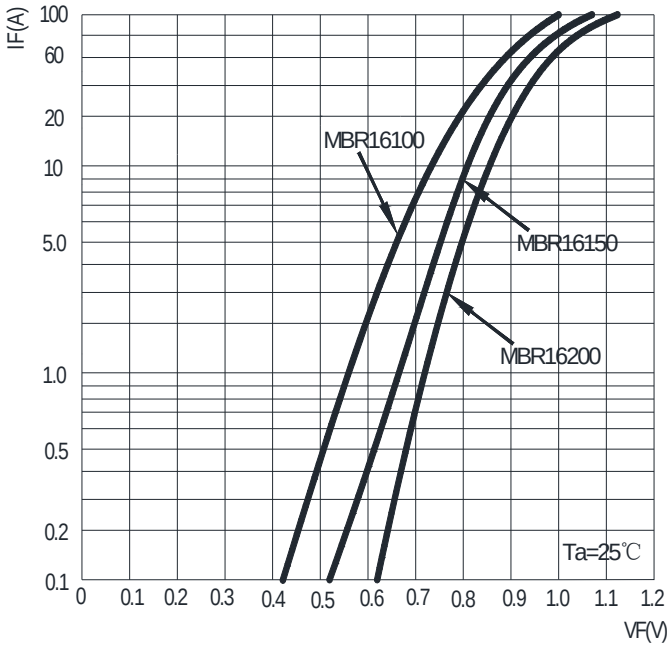


图4：反向电流曲线

FIG4:Typical Reverse Characteristics